출력 일자: 2004/10/23

발송번호 : 9-5-2004-043992805

수신 : 서울특별시 강남구 논현동 200번지

발송일자 : 2004.10.22

박장원 귀하

제출기일: 2004.12.22

135-826

1611718/19

2004. 10. 2

특허청 의견제출통지서

출원인

명칭 엘지전자 주식회사 (출원인코드: 120020128403)

주소 서울특별시 영등포구 여의도동 20번지

대리인

성명 박장원

주소 서울특별시 강남구 논현동 200번지

출원번호

10-2002-0075492

발명의 명칭

광 발생기 모듈, 광 검출기 모듈, 그들을 결합한 광픽업장치 및 그들 의 제조방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하으니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[0] 으

이 출원의 특허청구범위 제 7 항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통 상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29 조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

1) 본원은 고밀도 광 정보 저장 장치용 광 발생기 모듈과 광 검출기 모듈 및 광 픽업장치를 초소형화할 수 있는 것으로, 상부 실리콘 충과 하부 실리콘 충 사이에 실리콘 산화막이 형성되어 이루어진 소정면적을 가지는 판체상의 SOI 기판, SOI 기판의 상부 실리콘 층이 제거되어 형성된 제거부의 저면에 부착되는 전극용 금속패드, 전극용 금속패드의 상면에 부착되며 발광 소자인 레이저다이오드, SOI기판에 형성된 제거부의 일측에 실리콘 층이 제거되며 45°경사지게 형성되어 레이저다이오드에서 출사되는 광을 반사하는 미러를 구비하여 구성되는 것을 특징으로 하고 있습니다.

2) 청구범위 제 7 항에 기재된 발명은 일본 공개특허공보 평13-102676호(2001.4.13)의 도면등에 기재된 LD와 PD를 일체로 형성한 광픽업장치에서 기판상에 전극, 레이저 다이오드, 미러를 형성하여 레이저 다이오드 모듈을 구현하는 것을 특징으로 하는 광픽업 및 광기록매체 구동장치에 기재된 기술과 일본 공개특허공보 평10-256648호(98.9.25)의 도면 1,3,6 등에 기재된 측벽을 보유한 본체, 전극층, 레이저 다이오드, 레이저 다이오드에서 출사된 광을 반사시키는 미러등으로 구성되는 것을 특징으로 하는 레이저 다이오드 모듈에 기재된 기술과 대비했을때, 일부 구성상의 차이가 있다고 할 수 있으나 이는 당업자가 상황에 따라서 단순히 설계변경할 수 있는 정도의 기술범주에 해당하는 것으로 인정됩니다.

[첨 부]

첨부 1 일본 공개특허공보 평13-102676호(2001.04.13) 첨부2 일본 공개특허공보 평10-256648호(1998.09.25) 1부. 끝.

2481

中 3 年 3 年 3 年 3